Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО УМС ЛАПЛАЗ

Протокол № 1/08-577

от 29.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Направление подготовки (специальность)

[1] 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
7	3	108	32	16	0		33	0	Э
8	2	72	12	24	0		9	0	Э
Итого	5	180	44	40	0	0	42	0	

АННОТАЦИЯ

Основные области физики твердого тела, изучение которых предусмотрено программой курса и специализацией групп по лазерной физике. Рассматриваются основы кристаллографии, а также методы определения кристаллических структур, различные виды кристаллических связей и дефектов в твердых телах. Описаны колебания кристаллической решетки атомов и обосновано введение понятия «фонон». Основное внимание уделяется металлам и полупроводникам в соответствии с требованиями специализации группы. Поэтому подробно обсуждается зонная теория кристаллов наряду со связью зонной структуры с электрическими свойствами металлов и полупроводников. Также даны основы контактных явлений и детальный анализ работы р-п перехода в качестве одного из основных элементов полупроводниковых лазеров.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Показать многообразие физических явлений, протекающих в конденсированной фазе вещества. Научить оценивать характерные энергии, длины, времена релаксации различных физических взаимодействий в веществе, познакомить с основными подсистемами кристаллического состояния – решеткой Браве, фононной и электронной подсистемами. Дать ориентацию в различных экспериментальных методиках и теоретических описаниях, исследующих твердое тело.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам физикоматематических специальностей: уравнения математической физики, квантовая механика, макроэлектродинамика, теория вероятностей, статистическая физика и термодинамика.

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по курсам общей физики и университетскому курсу математики. Необходимо уметь работать с операторами, знать дифференциальное и интегральное исчисление, тензорный и векторный анализ, статистику и термодинамику, электричество и магнетизм, в том числе в материальных средах. Необходимо ориентироваться в задачах квантовой механики и статистической физики, основные квантовые и классические распределения, элементы квантовой статистики.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

=	
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача Объект или Код и наименование Код и наименование

профессиональной деятельности (ЗПД)	область знания	профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	индикатора достижения профессиональной компетенции
	научно-исс	следовательский	
Разработка лазерных и оптических технологий; анализ поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики; экспериментальные исследования в области фотоники и оптоинформатики новых явлений, материалов, систем и устройств	Лазерные технологии, элементы в составе лазерных систем, оптические материалы и детали, дифракционные оптические элементы, голограммы	ПК-1 [1] - способен к анализу поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики Основание: Профессиональный стандарт: 29.004	3-ПК-1[1] - Знать современное состояние развития фотоники и оптоинформатики; У-ПК-1[1] - уметь анализировать исходные требования при решении задач в области фотоники и оптоинформатики проводить поиск научнотехнической информации по теме решаемой задачи уточнять и корректировать требования к решаемой задаче в области фотоники и оптоинформатики; В-ПК-1[1] - Владеть навыками анализа простых исследовательских задач в области фотоники и оптоинформатики;
Разработка лазерных и оптических технологий; анализ поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики; экспериментальные исследования в области фотоники и оптоинформатики и оптоинформатики новых явлений, материалов, систем и устройств	Лазерные технологии, элементы в составе лазерных систем, оптические материалы и детали, дифракционные оптические элементы, голограммы	ПК-3 [1] - способен к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем Основание: Профессиональный стандарт: 29.004	3-ПК-3[1] - знать основы теории измерений основы работы с измерительной аппаратурой основы оптикофизических измерений; ; У-ПК-3[1] - Уметь пользоваться основными измерительными и сервисными приборами юстировать оптические установки.

В-ПК-3[1] - Владеть
методами и приемами
наладки, настройки,
юстировки и опытной
проверки приборов и
систем

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование
воспитание	обеспечивающих, формирование	воспитательного потенциала
	научного мировоззрения, культуры	дисциплин/практик «Научно-
	поиска нестандартных научно-	исследовательская работа»,
	технических/практических решений,	«Проектная практика»,
	критического отношения к	«Научный семинар» для:
	исследованиям лженаучного толка	- формирования понимания
	(B19)	основных принципов и
		способов научного познания
		мира, развития
		исследовательских качеств
		студентов посредством их
		вовлечения в
		исследовательские проекты по
		областям научных
		исследований. 2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин "История науки и
		инженерии", "Критическое
		мышление и основы научной
		коммуникации", "Введение в
		специальность", "Научно-
		исследовательская работа",
		"Научный семинар" для:
		- формирования способности
		отделять настоящие научные
		исследования от лженаучных
		посредством проведения со
		студентами занятий и
		регулярных бесед;
		- формирования критического
		мышления, умения
		рассматривать различные
		исследования с экспертной
		позиции посредством
		обсуждения со студентами
		современных исследований,
		исторических предпосылок
		появления тех или иных
		открытий и теорий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование

воспитание обеспечивающих, формирование воспитательного потенциала творческого дисциплин профессионального инженерного/профессионального модуля для развития навыков мышления, навыков организации коммуникации, командной коллективной проектной работы и лидерства, деятельности (В22) творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: - формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рациональнотехнологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	7 Семестр	1.0	1.5/0/0			7477 0	D 774.4
1	Раздел 1	1-8	16/8/0		25	КИ-8	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
2	Раздел 2	9-16	16/8/0		25	КИ-16	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
	Итого за 7 Семестр		32/16/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	Э	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
1	8 Семестр	1.0	0/1.6/0		25	TCTT O	D 1716 4
1	Раздел 1	1-8	8/16/0		25	КИ-8	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
2	Раздел 2	9-12	4/8/0		25	КИ-12	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3
	Итого за 8 Семестр		12/24/0		50		
	Контрольные мероприятия за 8 Семестр				50	Э	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,	
		час.	час.	час.	
1.0	7 Семестр	32	16	0	
1-8	Раздел 1	16	8	0	
1	Кристаллические структуры		аудиторных		
	Основные определения, решетка Браве, элементарная	2	1	0	
	ячейка, примитивная ячейка, ячейка Вигнера-Зейтца,		Онлайн		
	базисные векторы. Примеры ОЦК и ГЦК решеток, координационные сферы, коэффициент заполнения. Оси симметрии.	0	0	0	
2 - 3	Типы химических связей в твердых телах	Всего а	аудиторных	часов	
	Классификация твердых тел. Молекулярные кристаллы, их	4	2	0	
	основные физические свойства. Потенциал Леннарда-	Онлайі	H		
	Джонса, когезионная энергия, модуль упругости. Ионные	0	0	0	
	кристаллы, их основные физические свойства. Потенциал				
	Борна-Майера, постоянная Маделунга, модуль упругости.				
	Валентные и полупроводниковые кристаллы, их основные				
	физические свойства. Металлические кристаллы, их				
	основные физические свойства. Кристаллы с водородной				
	связью, квантовые кристаллы				
4	Обратная решетка	Всего а	аудиторных	часов	
	Определение, базисные векторы, объем, атомная	2	1	0	
	плоскость, индексы Миллера. Условие дифракции.	Онлайн			
	Построение Эвальда, Бриллиюна. Основные методы	0	0	0	
	определения кристаллических структур из рентгеновского				
	рассеяния (Лауэ, качаний, Дебай-Шерер).				
5	Дефекты в кристаллах	Всего а	аудиторных	часов	
	Фононы. Дефекты по Шоттки, по Френкелю. F - центры.	2	1	0	
	Дефекты в ионных кристаллах. Дислокации, поляроны и	Онлайі	H		
	экситоны.	0	0	0	
6 - 7	Фононы - колебания кристаллической решетки	Всего а	аудиторных	часов	
	Спектры фононов. Основные свойства фононных мод.	4	2	0	
	Оптические, акустические ветви, поляризация. Способы	Онлайн			
	определения спектров из взаимодействия с	0	0	0	
	электромагнитной волной, из нейтронного рассеяния.				
	Модель Дебая и Эйнштейна. Проблемы классической				
	модели. Теплоемкость и способы ее определения. Вклад				
	электронной подсистемы. Решеточная теплопроводность				
	кристаллов. Температурная зависимость. Процессы				
	переброса. Параметры Грюнайзена.				
8	Взаимодействие излучения с периодически	Всего а	аудиторных	часов	

	DAANA JAMANUU MAN D HIDAATIDA WATIDA WANTIDANIN DAAAAANA	2	1	0
	расположенными в пространстве центрами рассеяния	Онлай	<u> 1</u>] U
	Амплитуда рассеяния. Атомный, структурный форм-			
	факторы. Влияние разупорядочения. Фактор Дебая-Валлера. Определение фононной плотности состояний	0	0	0
9-16	Раздел 2	16	8	0
9 - 10	Металлическая связь	Всего	аудиторны	х часов
	Электронный газ и статистика Ферми-Дирака. Плотность	4	2	0
	электронных состояний. Уровень Ферми. Средняя энергия	Онлай	Н	
	электронов. Теплоемкость. Когезионная энергия металла.	0	0	0
	Параметр rs. Кинетические явления в металле. Модель			
	Друде-Лоренца.			
11	Кинетические явления в металлах	Всего	аудиторны	х часов
	Электропроводность, диэлектрическая проницаемость.	2	1	0
	Длина свободного пробега. Скин-эффект. Время	Онлай	Н	
	релаксации и концентрация примесей. Закон Видемана-	0	0	0
	Франца. Фононы в металле.			
12	Носители заряда в зонной схеме	Всего	аудиторны	
	Движение электрона в периодическом потенциале.	2	1	0
	Приближение сильной связи. Зоны Бриллюэна.	Онлай	Н	
	Эффективная масса. Блоховские электроны. Понятие о	0	0	0
	дырке. Проводимость в зонной схеме.			
13 - 14	Полупроводники	Всего	аудиторны	х часов
	Собственный полупроводник. Концентрация электронов и	4	2	0
	дырок. Закон действующих масс. Положение уровня	Онлай	Н	
	Ферми в собственном полупроводнике. Подвижность.	0	0	0
	Температурная зависимость. Примесный полупроводник.			
	Температурная зависимость концентрации носителей.			
	Примесная зона. Полуметаллические состояния.			
	Равновесные и неравновесные носители заряда. Время			
	жизни. Квазиуровень Ферми. Рекомбинация. Линейная и			
	квадратичная. Поглощение света. Прямые и непрямые			
	переходы. Контактная разность потенциала. Генерация,			
	диффузия и дрейф в примесном полупроводнике.			
15	Термоэлектрические эффекты	Всего	аудиторны	
	Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. Эффект Томпсона.		1	0
	Вывод формулы для коэффициента термоЭДС.	Онлай		1
		0	0	0
16	Гетероструктуры на основе полупроводников	Всего	аудиторны	х часов
	Уровни размерного квантования и двумерный	2	1	0
	электронный газ. Сверхрешетки.	Онлай	Н	
		0	0	0
	8 Семестр	12	24	0
1-8	Раздел 1	8	16	0
1	Контактные явления в полупроводниках	Всего	аудиторны	х часов
	Контакт металл- полупроводник. Область обедненного	1	2	0
	заряда. Запорный слой. Антизапорный слой. Барьер	Онлай	Н	
	Шоттки. Элементарные представления о р-п - переходе.	0	0	0
	Выпрямление. Вывод вольтамперной характеристики.			
	Квазиуровень Ферми на границе раздела. Туннельные			
	диоды. Гетеропереход.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2	Полупроводники в сильных электрических полях	Всего	аудиторны	х часов
	ВАХ N-типа. Эффект Ганна. Туннельный эффект.	1	2	0

		Онлай	H			
		0	0	0		
3	Генерация и рекомбинация	<u> </u>	⊥ ∽ аудиторнн			
	Излучательная рекомбинация. Безизлучательная	1	2	0		
	рекомбинация. Кинетика носителей заряда. Время жизни.	Онлай		10		
	Глубокие примеси. Рекомбинация ОЖЭ.	0	0	0		
4	Фотопроводимость		⊥∽ аудиторнн			
•	Фотомагнитный эффект. Вывод формул для ЭДС	1	2	0		
	фотомагнитного эффекта. Фотомагнитомеханический	Онлай	<u> 1 –</u> Н			
	эффект. Люминесценция. Флюоресценция. Механизмы	0	0	0		
	люминесценции в полупроводниках.					
5	Сегнетоэлектричество	Всего	аудиторны	ых часов		
	Сегнетова соль. Физические основы. Применение.	1	2	0		
		Онлай	H	L		
		0	0	0		
6	Эффект Холла	Всего	аудиторны	их часов		
	Коэффициент Холла и магнитосопротивление. Угол	1	2	0		
	Холла. Методы измерения и интерпретации	Онлай	H	L		
	экспериментальных данных. Особенности поведения	0	0	0		
	магнитосопротивления для многозонных веществ.					
	Квантовый эффект Холла. Эффект Эттингсгаузена					
7	Циклотронный резонанс	Всего	аудиторны	ых часов		
	Циклотронный резонанс, эксперимент Азбеля-Канера.	1	2	0		
	Эффективная циклотронная масса. Получение	Онлай	Н			
	информации о зонной структуре.	0	0	0		
8	Эффект де-Гааза-ван-Альфена	Всего	аудиторны	ых часов		
	Уровни Ландау. Условия проведения эксперимента.	1	1 2 0			
	Построение поверхностей Ферми. Гигантские квантовые	Онлай	Н			
	осцилляции поглощения ультразвука в металлах.	0	0	0		
	Восстановление зонной структуры.					
9-12	Раздел 2	4	8	0		
9	Гамма-резонансная спектроскопия	Всего	аудиторны	их часов		
	Эффект Мессбауэра, "мессбауэровские" изотопы.	1	2	0		
	Интерпретация мессбауэровских спектров. Изомерный	Онлай	Н			
	сдвиг. Квадрупольное расщепление, расщепление уровней	0	0	0		
	ядра в магнитном поле соседних электронов. Фактор					
	Лэмба-Мессбауэра. Влияние температуры на					
1.0	мессбауэровские спектры.					
10	Аннигиляция позитронов в веществе	Всего	аудиторны			
	Диагностика электронной структуры. Основы метода.	1	2	0		
	Источники позитронов. Схема эксперимента для	Онлай	1			
	измерений двухквантовой аннигиляции позитронов.	0	0	0		
1.1	Интерпретация экспериментальных данных	D				
11	Магнитные резонансы: ЯМР, ЭПР	Всего	аудиторны			
	Метод ядерного магнитного резонанса в физике твердого	0	2	0		
	тела. Основы метода. Спектры ЯМР. Продольная и	Онлай	1			
	поперечная релаксация. Ядра, представляющие интерес	0	0	0		
	для ЯМР-спектроскопии. Интерпретация спектров ЯМР:					
	положение, интенсивность, дисперсия тонкой структуры. Сдвиг Найта. Метод электронного парамагнитного					
	резонанса. Основы метода. Отличия метода ЭПР от ЯМР-					
	резонанеа. Основы метода. Отличил метода эти от лит-		1			

	метода. Спектры ЭПР, спин-решеточная и спин-спиновая			
	релаксация. Интерпретация спектров ЭПР.			
12	Двойные резонансы и методы EXAFS	Всего а	удиторных	часов
	Акустический парамагнитный резонанс, акустический	1	2	0
	ядерный магнитный резонанс, двойной электронно-	Онлайі	H	
	ядерный резонанс. Общие представления.	0	0	0
	Фотоэмиссионные и инверсные фотоэмиссионные			
	спектры. Методы XANES, EXAFS - исследование			
	электронной подсистемы твердого тела.			

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

Недели	Темы занятий / Содержание				
	7 Семестр				
1 - 8	Кристаллические структуры				
	Основные определения. Типы химических связей в твердых телах. Обратная решетка.				
	Условие дифракции. Дефекты в кристаллах. Фононы. Амплитуда рассеяния.				
	Атомный, структурный форм-факторы.				
9 - 16	Электронная подсистема				
	Металлическая связь. Электронный газ и статистика Ферми-Дирака. Кинетические				
	явления в металлах. Носители заряда в зонной схеме. Зоны Бриллюэна. Эффективная				
	масса. Полупроводники. Термоэлектрические эффекты. Гетероструктуры на основе				
	полупроводников.				
	8 Семестр				
1 - 6	Полупроводники				
	Контактные явления в полупроводниках. Генерация и рекомбинация.				
	Фотопроводимость. Эффект Холла.				
	Экспериментальные методы исследования твердых тел				
	Циклотронный резонанс. Эффект де-Гааза-ван-Альфена. Гамма-резонансная				
	спектроскопия. Аннигиляция позитронов в веществе. Ядерный магнитный резонанс.				
	Электронный парамагнитный резонанс. Фотоэмиссионные и инверсные				
	фотоэмиссионные спектры.				

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используются презентации, обсуждения последних научных работ, новые модели в физике конденсированного состояния. Обязательным условием успешного освоения дисциплины является самостоятельная работа студентов, выполнение индивидуальных заданий, работа с литературой.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)	Аттестационное мероприятие (КП 2)
ПК-1	3-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-3	3-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической

			последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ А 71 Введение в теорию полупроводников : учебное пособие, Ансельм А. И., Санкт-Петербург: Лань, 2016
- 2. 621.38 О-62 Оптоэлектроника Ч.1 Физические основы полупроводниковой оптоэлектроники. Когерентная оптоэлектроника, , Москва: Янус-К, 2010
- 3. 538.9 П30 Основы физики конденсированного состояния : учебное пособие, Петров Ю.В., Долгопрудный: Интеллект, 2013
- 4. ЭИ П 19 Полупроводниковые приборы : Учебное пособие для вузов, Пасынков В. В., Чиркин Л. К., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 5. ЭИ Н63 Сборник задач по курсу "Физика твердого тела" : , Маймистов А.И., Николаев И.Н., Москва: МИФИ, 2009
- 6. 539.2 Н63 Сборник задач по курсу "Физика твердого тела" : , Маймистов А.И., Николаев И.Н., Москва: НИЯУ МИФИ, 2009
- 7. 538.9 С24 Сверхтекучесть и бозе-конденсация : учебное пособие для вузов, Маймистов А.И. [и др.], Москва: МИФИ, 2008
- 8. 539.2 К31 Современные проблемы физики твердого тела Ч.1 Целый и дробный квантовые эффекты Холла, Кашурников В.А., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011
- 9. 530 Л22 Теоретическая физика Т.3 Квантовая механика. Нерелятивистская теория, Ландау Л.Д., Москва: Физматлит, 2024
- 10.53~Л22~Теоретическая физика Т.5~Статистическая физика.Ч.1, Ландау Л.Д., Москва: Физикатлит, 2013
- 11. ЭИ К12 Теоретическая физика твердого тела:, Собакин В.Н., Каган Ю.М., Ивлиев С.В., М.: МИФИ, 2009

- 12. ЭИ Ш 18 Физика полупроводников : учебное пособие, Шалимова К. В., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 13. ЭИ С 77 Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов, Старосельский В. И., Москва: Юрайт, 2022
- $14.620 \Phi 50 \Phi$ изическое материаловедение Т.1 Физика твердого тела, , Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
- 15. 536 К31 Численные методы квантовой статистики: , Красавин А.В., Кашурников В.А., Москва: Физматлит, 2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 533 Ч-43 Введение в физику плазмы:, Чен Ф.Ф., М.: Мир, 1987
- 2. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., М.: Наука, 1978
- 3. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., Москва: Физматлит, 1963
- 4. 530.5 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., М.: Физматгиз, 1962
- 5. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., М.: МедиаСтар, 2006
- 6. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., М.: Гостехиздат, 1957
- 7. 538.9 Б87 Квазичастицы в физике конденсированного состояния:, Кульбачинский В.А., Брандт Н.Б., М.: Физматлит, 2005
- 8. ЭИ К 89 Межфазные взаимодействия при гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов : монография, Москвин П. П., Кузнецов В. В., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 9. 530 3-17 Принципы теории твердого тела:, Займан Дж., Москва: Мир, 1966
- 10. 53 3-17 Принципы теории твердого тела:, Займан Дж., Москва: Мир, 1974
- 11. 539.2 Н63 Сборник задач по курсу "Физика твердого тела" : , Маймистов А.И., Николаев И.Н., М.: МИФИ, 1998
- 12. 539.2 Н63 Сборник задач по курсу "Физика твердого тела" : Учеб. пособие, Маймистов А.И., Николаев И.Н., М.: МИФИ, 1990
- 13. 539.2 М13 Теория твердого тела: , Маделунг О., М.: Наука, 1980
- 14. ЭИ А 46 Технология полупроводниковых материалов:, Греков Ф. Ф., Александров С. Е., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 15. 621.37 С80 Физика полупроводников: , Стильбанс Л.С., М.: Сов. радио, 1967
- 16. 530 У98 Физика твердого тела:, Томсон Р., Уэрт Ч., М.: Мир, 1966

- 17. 539.2 Г95 Физика твердого тела : учеб. пособие для техн. ун-тов, Гуревич А.Г., СПб: Невский диалект; БХВ-Петербург, 2004
- 18. 539.2 А98 Физика твердого тела Т.1, Ашкрофт Н., М.: Мир, 1979
- 19. 539.2 А98 Физика твердого тела Т.2, Ашкрофт Н., М.: Мир, 1979
- 20. 539.2 М13 Физика твердого тела. Локализованные состояния : , Маделунг О., М.: Наука, 1985
- 21. 539.2 Б87 Экспериментальные методы исследования энергетических спектров электронов и фононов в металлах : Физические основы, Чудинов С.М., Брандт Н.Б., М.: МГУ, 1983

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- 1. Freemat (http://freemat.sourceforge.net)
- 2. Компилятор Fortran (http://gcc.gnu.org/wiki/GFortran)

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

- 1. сайт кафедры №70 НИЯУ МИФИ (http://kaf70.mephi.ru/)
- 2. сайт Американского физического общества (http://www.aps.org)
- 3. сайт издательства Elsevier ()

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

необходимо твердо усвоить современные представления о кристаллических структурах, о методах их экспериментального определения, о фононной и электронной подсистемах твердого тела, о классификации твердых тел. Следует изучить основные методы определения фононного спектра, плотности фононных состояний. Понимать значение фактора Дебая-Валлера в амплитуде рассеяния. Иметь представление о дефектах структуры, об элементарных возбуждениях. Знать особенности ионной связи, расчета постоянной Маделунга.

Необходимо уметь оценивать характерные параметры различных подсистем в конденсированной фазе, уметь ориентироваться в многообразии физических явлений твердого состояния. Знать особенности электронной подсистемы твердого тела, вид блоховской волновой функции, особенности зонной структуры и движения блоховского электрона во внешних полях. Уметь объяснить различие металла и диэлектрика, полуметалла и полупроводника. Рассчитывать статистику электронов и дырок, понимать значение эффективной массы для динамики носителей заряда. Знать основные методы определения

концентрации носителей и знака их заряда, методы расчета зонной структуры, примесных состояний.

Небходимо владеть современными теоретическими представлениями при описании взаимодействий атомов и электронных оболочек в кристалле, о термодинамических, оптических, магнитных и электрофизических свойствах твердых тел, а также представлять основные резонансно-магнитные и другие экспериментальные методы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Необходимо дать студентам основные представления об электронной и фононной подсистемах твердого тела.

Курс опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам физикоматематических специальностей: уравнения математической физики, квантовая механика, макроэлектродинамика, теория вероятностей, статистическая физика и термодинамика. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по курсам общей физики и университетскому курсу математики. Необходимо проверить умение работать с операторами, знать дифференциальное и интегральное исчисление, тензорный и векторный анализ, статистику и термодинамику, электричество и магнетизм, в том числе в материальных средах. Необходимо, чтобы студенты ориентировались в задачах квантовой механики и статистической физики, основные квантовые и классические распределения, элементы квантовой статистики. В процессе освоения материала следует дать основные представления об электронной и фононной классификации твердого тела, 0 межатомных связей, конденсированное состояние, о различных методах экспериментального исследования этих подсистем. Следует рассказать об основных общепринятых теоретических представлениях о физических процессах в твердых телах, об отличии твердого состояния от других агрегатных состояний вещества. Необходимо научить понятию о дальнем и ближнем порядке, о дефектах кристаллической структуры, о кинетических и термодинамических свойствах и моделях, описывающих эти свойства. Необходимо обсудить основные методы исследования структуры твердого тела: рентгеновские и нейтронные, методы измерения фононных спектров. Научить методам изучения зонной структуры: циклотронный резонанс, эффект де-Гааза-ван-Альфена, аннигиляция позитронов, фотоэмиссия, ЯМР и ЭПР, эффект Мессбауэра, эффект Холла. Достаточно подробно рассмотреть физику полупроводников, диффузию и дрейф носителей заряда, рекомбинацию и генерацию, контактные явления, поглощение, особенности эффекта Холла в полупроводниках. Рассказать о примесных полупроводниках, о донорах и акцепторах, о температурной зависимости проводимости, о квазиуровнях Ферми.

Автор(ы):

Кашурников Владимир Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор

Иванов Андрей Анатольевич, к.ф.-м.н., доцент